2SA1037K/2SA1576

= 7-27-09

トランジスタ

2SA1037K 2SA1576

トランジスタ/Transistors

● 特長

1) 低雑音である。 NF=0.5dB Typ.

2) 2SC2412K/2SC4081とコンプリである。

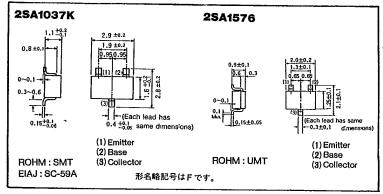
Features

- 1) Low noise: NF=0.5dB (Typ.)
- 2) Complementary pair with 2SC2412K/2SC4081.

エピタキシァルプレーナ形スーパー/ウルトラミニモールド PNP シリコントランジスタ

一般小信号增幅用/General Small Signal Amp. Epitaxial Planar Super/Ultra Mini-Mold PNP Silicon Transistors

● 外形寸法図/Dimensions (Unit:mm)



● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol Limits		Unit	
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	-50	V	
コレクタ・エミッタ間電圧	VCEO	-40	V	
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	-5	٧	
コレクタ電流	lo	-100	mA	
コレクタ損失	Po	200	mW	
接合部温度	TJ	125	ా	
保存温度範囲	Tstg	-55~125	င	

● 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BVCEO	-40	_	_	V	Ic=-1mA
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CBO}	-50		_	V	Ic=-50 µA
エミッタ・ベース降伏電圧	BVEBO	– 5			V	I _E =-50 μA
コレクタしゃ断電流	Ісво		_	-0.5	μА	V _{CB} =-30V
エミッタしゃ断電流	IEBO	_	_	-0.5	μА	V _{EB} =-4V
直流電流増幅率	hFE	120	_	560	_	Vce /lc=-6V/-1mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	VCE(sat)	_	_	-0.5	V	Ic/IB=-50mA/-5mA
利得帯域幅積 (トランジション周波数)	f _T	_	140	_ ·	MHz	Vce =-12V, I e=2mA
コレクタ出力容量	Cob		3.5	-	pF	V _{CB} =-12V, I _E =0, f=1MHz

hFEの値により下表のように分類します。

Item	'Q	R	S
hFE	120~270	180~390	270~560

標準品・準標準品一覧表

包装名

(◎:標準品 ○:準標準品)						
	テーピング					
	T146	T147	T106	T107		
2(個)	3 000	3 000	3 000	3 000		

		記号	T146	T147	T106	T107
Туре	hFE	基本発注単位(個)	3 000	3 000	3 000	3 000
2SA1037K	QRS		0	0		-
2SA1576	QRS			_	0	0

ROHM

139

T-27-09

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

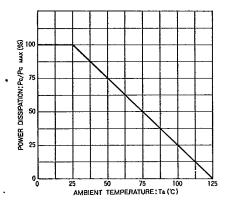


Fig.1 電力軽減曲線

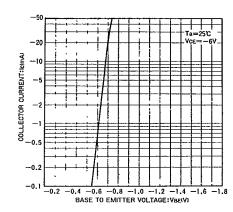


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

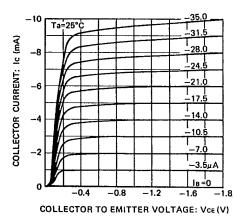


Fig.3 エミッタ接地出力静特性 (I)

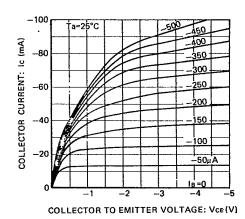


Fig.4 エミッタ接地出力静特性(Ⅱ)

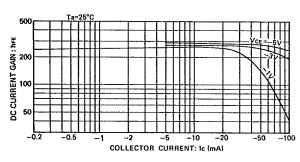


Fig.5 直流電流増幅率 - コレクタ電流特性

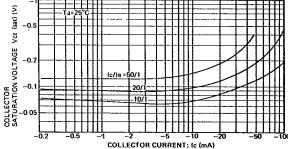


Fig.6 コレクタ・エミッタ飽和電圧 -- コレクタ電流特性

140

Radin.

トランジスタ/Transistors

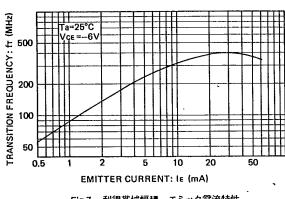
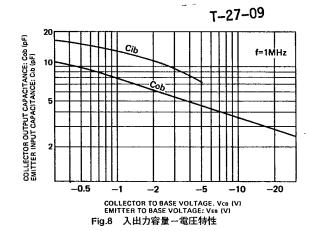


Fig.7 利得帯域幅積-エミッタ電流特性





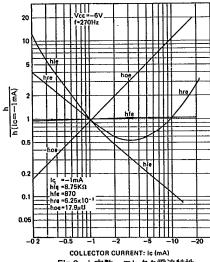


Fig.9 h定数-コレクタ電流特性